

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 20 年 9 月 4 日 (2008.9.4)

【公表番号】特表 2008-511172 (P2008-511172A)
 【公表日】平成 20 年 4 月 10 日 (2008.4.10)
 【年通号数】公開・登録公報 2008-014
 【出願番号】特願 2007-529864 (P2007-529864)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/338 (2006.01)

H 0 1 L 29/778 (2006.01)

H 0 1 L 29/812 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 29/80 H

【手続補正書】
 【提出日】平成 20 年 7 月 10 日 (2008.7.10)

【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体構造であって、
 第 1 半導体層と、
 前記第 1 半導体層上の第 2 半導体層と、
 前記第 2 半導体層上の第 3 半導体層と、
 前記第 3 半導体層上の第 4 半導体層と、
 前記第 1 半導体層に結合した第 1 導電体部分と、
 前記第 1 半導体層上の第 2 導電体部分とを備える半導体構造。

【請求項 2】

前記第 2 半導体層は、第 1 凹部層を備え、
前記第 3 半導体層は、第 2 凹部層を備え、
前記第 4 半導体層は、第 3 凹部層を備える請求項 1 に記載の半導体構造。

【請求項 3】

前記第 2 導電体部分は、前記第 1 凹部層から電氣的に絶縁されている請求項 2 に記載の半導体構造。

【請求項 4】

半導体構造の製造方法であって、
第 1 半導体層を形成する工程と、
前記第 1 半導体層上に第 2 半導体層を形成する工程と、
前記第 2 半導体層上に第 3 半導体層を形成する工程と、
前記第 3 半導体層上に第 4 半導体層を形成する工程と、
前記第 2 半導体層に結合した第 1 導電体部分を形成する工程と、
前記第 1 半導体層上に第 2 導電体部分を形成する工程とを備える方法。

【請求項 5】

開口を形成するために、前記第 2 半導体層をパターニングする工程であって、前記第 1 導電体層の一部分は、前記開口内にある、第 2 半導体層のパターニング工程と、
前記第 2 半導体層に対して前記第 3 半導体層に凹部形成するために、前記第 3 半導体層

をパターニングする工程と、

前記第 3 半導体層に対して前記第 4 半導体層に凹部形成するために、前記第 4 半導体層をパターニングする工程とをさらに備える請求項 4 に記載の方法。